

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА UBe₁₃ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ СОСТОЯНИИ

H.E. Алексеевский, A.B. Митин

Измерены зависимости намагниченности $M(H)$ от магнитного поля для монокристалла UBe₁₃ при $T < T_c$. Из полученных данных определены значение термодинамического поля H_c (0,1 К) = 920 Э, параметр Гинзбурга – Ландау $\kappa = 60$ и глубина проникновения $\lambda = 3,6 \cdot 10^{-5}$ см. Проведенные оценки показывают, что ряд свойств UBe₁₃ может быть достаточно удовлетворительно описан в рамках представлений об обычной сверхпроводимости, если предположить, что UBe₁₃ имеет две группы взаимодействующих между собой носителей тока – "тяжелые" и "легкие".

Как известно, у соединения UBe₁₃ наблюдается исключительно большая электронная теплоемкость C_p (1 К) $\sim \gamma T \approx 1$ Дж/моль · К и сравнимый с ней по величине скачок теплоемкости при переходе в сверхпроводящее состояние ΔC ¹. Кроме того, ниже T_c зависимость $C_p(T)$ не является экспоненциальной, как это следует из теории БКШ. Аномально большая электронная теплоемкость согласуется с весьма большими значениями $|dH_{c2}/dT|_{T_c} > 200$ кЭ/К^{2,3}.

Представляло интерес исследовать намагниченность UBe₁₃ при $T < T_c$ и сравнить с имеющимися данными для других "тяжелофермионных" сверхпроводников, таких, как CeCu₂Si₂⁴ и UPt₃⁵.

Измерения $M(H)$ проводились на монокристалле UBe₁₃, представлявшем собой параллелепипед с размерами $2 \times 2 \times 15$ мм³, вырезанном вдоль оси C_4 . Рентгенодифракционный анализ образца не выявил каких-либо посторонних фаз. Для измерений $M(H)$ использовались два метода. В первом методе проводилось измерение магнитной индукции исследуемого образца как функции магнитного поля, и из полученных кривых $B(H)$ определялась намагниченность. Для измерения $B(H)$ использовались два миниатюрных висмутовых датчика магнитного поля, которые располагались на взаимноперпендикулярных гранях образца. Температура ниже 1 К достигалась при адиабатическом размагничивании эрбий-иттрий-алюминиевого граната – использовался прибор, подобный описанному в⁶, который ранее применялся для определения зависимостей $H_{c2}(T)$ у UBe₁₃².

Результаты измерений разности магнитного поля на датчиках ΔH в зависимости от приложенного внешнего поля при двух значениях температуры 0,1 и 0,3 К показаны на рис. 1. Поскольку величина ΔH пропорциональна намагниченности M , то из полученных зависимостей можно было оценить¹⁾ значение термодинамического поля H_c и параметр Гинзбурга – Ландау k . С повышением T от 0,1 до 0,3 К $H_c(T)$ уменьшается от 920 ± 50 до 680 ± 50 Э, а параметр $k = 60 \pm 5$ в пределах погрешности измерений остается неизменным. Этим же методом были проведены контрольные измерения $M(H)$ на идентичном по размерам параллелепипеде из Nb. В этом случае было получено: $H_c(4,2 \text{ К}) = 2,8 \text{ кЭ}$ и $k = 3$, что неплохо согласуется с опубликованными данными.

Во втором методе $M(H)$ определялась по сигналу разбаланса двух скомпенсированных катушек, в одной из которых находилась ампула с охлажденным до низкой температуры образцом. Сами катушки были расположены в дьюаре с жидким гелием и подключались к микроволновому берметру. Сигнал разбаланса записывался на самописце при изменении внешнего магнитного поля, параллельного оси образца. (Подобный метод использовался ранее в⁷⁾).

На рис. 2 показано семейство зависимостей $M(H)$, полученных вторым методом.

Для калибровки сигнала раскомпенсации катушек использовались близкие по размерам образцы олова и свинца. В области слабых полей наклон зависимостей $M(H)$ для UBe₁₃, как следует из сопоставления с аналогичными данными для Nb (в первом методе) и для Sn и Pb (во втором методе), оказывается примерно в два раза меньше, чем это можно было бы ожидать в случае идеального диамагнетика. Отсюда можно заключить, что образец UBe₁₃ содержит не менее 50% по объему сверхпроводящей фазы. Приблизительно такое же содержание сверхпроводящей фазы было зарегистрировано при исследовании $M(H)$ у образцов CeCu₂Si₂⁴ и UPt₃⁵.

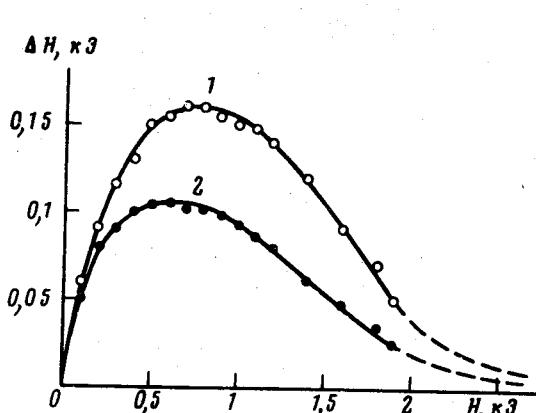


Рис. 1

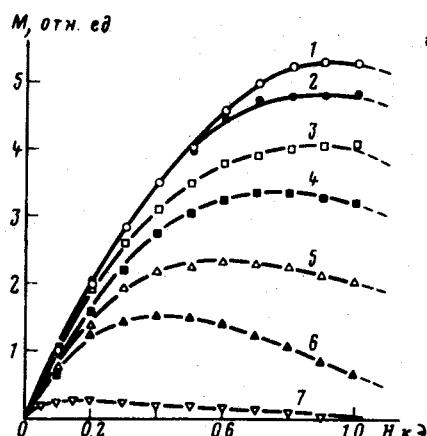


Рис. 2

Рис. 1. Изменение разности магнитного поля ΔH на двух взаимно перпендикулярных гранях монокристалла UBe₁₃ в зависимости от приложенного магнитного поля при двух значениях температур (К): $\circ - 0,1$; $\bullet - 0,3$.

Рис. 2. Семейство зависимостей намагниченности $M(H)$ от приложенного магнитного поля H монокристалла UBe₁₃ при нескольких значениях температур (К): $\circ - 0,31$; $\bullet - 0,36$; $\square - 0,39$; $\blacksquare - 0,57$; $\triangle - 0,70$; $\blacktriangle - 0,80$; $\nabla - 0,94$.

Если из приведенных выше значений H_c и k оценить глубину проникновения магнитного поля λ для UBe₁₃, воспользовавшись выражением $\lambda = (\Phi_0 k / 2\sqrt{2\pi} H_c)^{1/2}$, то для $T = 0,1 \text{ К}$ получим $\lambda = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ см}$. Эта величина в 2–2,5 раза больше, чем в случае CeCu₂Si₂⁴ и практически

¹⁾ При определении конфигурации магнитного поля вблизи образца использовались эквилюстрии, полученные в электролитической ванне.

совпадает с λ для $U\text{Pt}_3$ ⁵. Следует отметить, что значения λ для "тяжелофермионных" сверхпроводников с $m^* > 100 m_e$ мало отличаются от характерных значений λ для обычных сверхпроводников. Так, например, у $W\text{Be}_{13}$, характеризующегося почти в 1000 раз более низкими по сравнению с $U\text{Be}_{13}$ значениями $\gamma = 10^{-3}$ Дж/моль · К² и производной $|dH_c2 / dT|_{T_c} = 570$ Э/К², глубина проникновения $\lambda = 2,1 \cdot 10^{-5}$ см, определенная из H_c и k , отличается меньше, чем в два раза. Относительно небольшие величины λ , полученные для трех "тяжелофермионных" сверхпроводников, можно рассматривать как указание на то, что экранирование поля осуществляется в значительной мере "легкими" носителями с $m^* \approx m_e$. С другой стороны, ряд необычных свойств "тяжелофермионных" сверхпроводников, которые нельзя объяснить, учитывая лишь "легкие" носители, могут быть обусловлены взаимодействием "тяжелых" и "легких" носителей, например, *s-f* гибридизацией.

Авторы выражают признательность Ю.А.Денискину, В.И.Нижанковскому, Е.М.Гаврилову, Е.П.Хлыбову за помощь при проведении ряда измерений и Г.П.Прудковскому за исследование распределения поля в электролитической ванне.

Литература

1. Ott H.R., Rudigier H., Fisk Z., Smith J.L. Phys. Rev. Lett., 1983, **50**, 1595.
2. Алексеевский Н.Е. Письма в ЖЭТФ, 1984, **40**, 66.
3. Maple M.B., Chen J.W., Lambert S.E. et al. Phys. Rev. Lett., 1985, **54**, 477.
4. Rauchschwalbe U., Lieke W., Bredl C.D. et al. Phys. Rev. Lett., 1982, **49**, 1448.
5. Franse J.J.M., Frings P.H., de Visser A. et al. Physica, 1984, **126B**, 116.
6. Alekseevskii N.E., Dodokin A.P., Bazan C. et al. Cryogenics, 1981, **21**, 598.
7. Алексеевский Н.Е., Нижанковский В.И., Бертель К.-Х. ФММ, 1974, **37**, 63.